

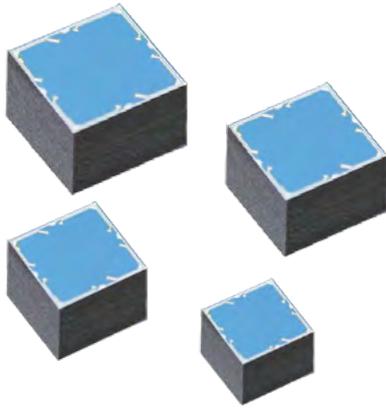
BW-MD系列

高稳定型单晶硅压力/差压传感器芯片

技术手册

BW-MD 系列高稳定型单晶硅压力 / 差压传感器芯片

产品特点



北微BW-MD系列高稳定型单晶硅传感器芯片，拥有多项**优秀**的性能，并已批量投向国际市场，在欧洲、亚洲已广泛应用于石油化工，冶金电力，工业自动化、航空航天、物联网等领域。

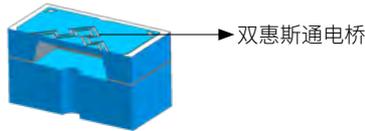
关键词

- 高纯度单晶硅材质
- 双梁悬浮式 MEMS 结构
- 超高过压性能
- 1kPa 标准量程

■ 高纯度单晶硅材质

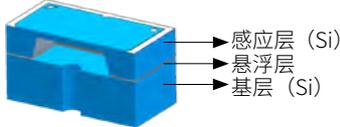
北微BW-MD系列单晶硅芯片采用超高纯度单晶硅材质，其材质特性优于市场上通用的复合硅、扩散硅材料。借此北微也打破了此种材料仅被几家**优秀**传感器公司垄断的格局。

■ "双梁" MEMS 设计



北微BW-MD系列单晶硅传感器芯片采用经典的惠斯通电桥原理，但在桥路设计上创新采用了双惠斯通电桥，在桥路上实现“双梁”。该双梁桥路，其桥阻温度特性互补，当桥路发生自热变化或噪声干扰时，双梁桥路实现自补偿，大幅提高芯片的抗干扰能力与长期稳定性。

■ "悬浮" MEMS 结构



北微BW-MD系列单晶硅传感器芯片采用全单晶硅材料，感应层与基层采取硅硅键合，从而提高芯片的静压特性（大大优于传统的硅玻璃键合），同时在感应层与基层中加入 μm 级厚度的惰性材质悬浮层，大大减小应力影响并提高绝缘特性。

■ 1kPa ... 40MPa 标准量程

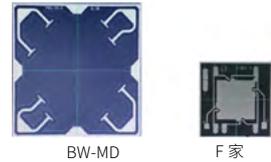
1kPa, 6kPa, 40kPa, 100kPa, 400kPa, 4MPa, 40MPa 七个标准量程，涵盖过程控制表压、差压、绝压全范围。目前拥有较小标准量程 1kPa, 保证微差压段较优性能。

■ 较好的过压性能

1kPa 芯片过压达 1.5MPa (1500 倍过压)
6kPa 芯片过压达 2.5MPa (417 倍过压)
借此优异的过压性能，绝大部分微差压应用可实现无保护膜片结构，提高整体准确度与静压特性，同时简化传感器结构、降低成本。

■ "梅花镜像" MEMS 布局

MEMS 硅传感器芯片都需要金属化工艺，将电桥桥阻内部引线引出，并形成一定面积的金属绑定区。此金属线与金属绑定区也将对硅感应膜面产生应力影响。某些厂家将引线引脚布局复杂而不对称，虽方便了多种引线方式，却由于金属材质与硅材质性能的不同，影响了传感器的温度与静压特性。北微BW-MD系列芯片采用全对称的“梅花镜像”式金属化布局，并将金属化部分布局在芯片的边缘，金属化部分在温度与压力变化时，变化均匀、对称抵消，使其影响降到较小。



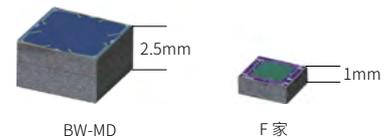
北微BW-MD芯片与友商 F 家芯片对比 (同量程)

■ 桥路电阻: 10k Ω (独创)

较大的桥路电阻可以有效控制温度影响，保证输出信号高信噪比，并降低功耗。

■ 单晶硅层厚度达 2.5mm

在 MEMS 传感器硅芯片技术中，硅片的尺寸与硅层的厚度对传感器芯片的成本和性能也起到很关键的作用。且一致的传感器芯片材质，有利于实现较佳的温度特性与静压特性。北微BW-MD系列芯片，采用全单晶硅材质，尺寸与厚度都为行业内显著的大尺寸，不惜成本，提高品质。



北微BW-MD芯片与友商 F 家芯片对比 (同量程)

厚硅 - 更加稳定

BW-MD系列

高稳定型单晶硅压力/差压传感器芯片

无锡北微科技有限公司

地址：无锡市滨湖区绣溪路 58 号 30 幢

总机：0510-85737158

热线：400-618-0510

邮箱：sales@bwsensing.com

网址：www.bwsensing.com.cn